

スーパークリーンルーム産学官連携研究棟 単価表

2021年4月1日改訂

※ 利用促進、中小企業支援、アカデミック利用のいずれかに該当すると判断される場合には、**50%の減額措置**を行います。
 ※ 処理の内容によっては、単価表に記載された金額よりも高くなる場合もあります。
 ※ 研究支援施設であるため、大量の試作については受け入れが難しい場合がございます。
 詳しくは担当窓口までお問い合わせください。

● プロセス装置 ・スーパークリーンルーム

装置区分	No.	装置番号 ※注1	施設等名称	共用施設等使用料			技術指導費等 ※注2				
				標準レンピを使用する場合 (円/枚)	チューニングが必要な場合 (円/時間)	同一の標準レンピを使用する場合(～25枚) (円/FOUP)					
露光装置	1	L01-104 L01-103	ArF液浸レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK LITHIUS i+) ArF液浸露光装置 (NSR-S610C) ※注3	80,000	240,000	1,000,000	10,000				
	2	M01-08 M01-10	KrFレジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12) KrF露光装置 (FPA-5000ES3) ※注3 ※注4	32,000	180,000	400,000	10,000				
	3	U01-102 U01-101	i線レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12) IRアライメント付i線露光装置 (FPA-5510iZs) ※注3	32,000	180,000	400,000	10,000				
塗布現像装置	4	L01-104c	ArF液浸レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK LITHIUS i+)	36,000	180,000	450,000	10,000				
	5	M01-08c	KrFレジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12) ※注4	24,000	120,000	300,000	10,000				
	6	U01-102c	i線レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12)								
7	M01-04	レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12)									
成膜装置	8	B03-07	プラズマCVD装置 (Eagle-12) ※注4	28,000	168,000	350,000	10,000				
	9	M03-06	プラズマCVD装置 (Eagle-12 Rapidfire) ※注4								
	10	B03-06	プラズマCVD装置 (VECTOR) ※注4								
	11	F03-103	プラズマCVD装置 (VECTOR)								
	12	M03-01	高密度プラズマCVD装置 (Concept 3 Speed)								
	13	P03-101	高密度プラズマCVD装置 (MAPLE) ※注4								
	14	M03-14	High-k ALD装置 (Trias-ALD)								
	15	M06-04	メタルCVD装置 (Trias-W)								
	16	F03-07	窒化膜LP-CVD装置 (TELFORMULA) ※注4								
	17	M03-03	酸化膜LP-CVD(TEOS)装置 (TELFORMULA) ※注4								
	18	P03-103	Doped-Si LP-CVD装置 (DJ1226V-DF)								
	19	U03-101B	プラズマCVD装置 (PRODUCER GT Staircase)								
	20	B06-101	バリアシードスパッタ装置 (Endura2 EnCoReII Ta/Cu) ※注4					40,000	120,000	500,000	10,000
	21	F06-101	新材料スパッタ装置 (jarim C-7100GT) ※注4								
	22	M06-03	メタルスパッタ装置 (COSMOS I-1201)					25,000	120,000	312,500	10,000
	23	M06-07	メタルスパッタ装置 (ENTRON W-300) ※注4								
24	B06-102	Cuめっき装置 (SABRE NExT)	50,000	140,000	625,000	10,000					
25	P03-105	Geエピ装置 (FC7200)	56,000	112,000		10,000					
26	AP03-101	SiGe/Ge成膜装置 (Epsilon)	56,000	112,000		10,000					
エッチング装置	27	M02-04	Poly-Siエッチング装置 (Centura DPSII/axiom) ※注4	65,000	180,000	812,500	10,000				
	28	M02-05	メタルエッチング装置 (Centura DPSII/ASPII) ※注4								
	29	B02-101	Low-k/メタルエッチング装置 (Centura Enabler/DPS232) ※注4	40,000	180,000	500,000	10,000				
	30	M02-01	酸化膜エッチング装置 (Telius SCCM-Ox/DRM-Ox) ※注4								
	31	M02-10	酸化膜エッチング装置 (Telius DRM-Ox/SCCM-Poly) ※注4								
	32	B02-01	Low-kエッチング装置 (Telius SCCM-Ox) ※注4	20,000	120,000	250,000	10,000				
	33	F02-101	新材料エッチング装置 (U-8150) ※注4								
アッシング装置	34	B02-03	アッシング装置 (ICE300/RPA300) ※注4								
	35	M02-07	アッシング装置 (μASH300) ※注4	14,000	150,000	175,000	10,000				
	36	P02-105	アッシング装置 (ICE300/μASH300) ※注4								
イオン注入装置	37	M05-03	高エネルギー中電流イオン注入装置 (EXCEED2300V) ※注4	69,000	196,000	862,500	10,000				
	38	F05-101	低エネルギー高電流イオン注入装置 (SHX) ※注4								
熱処理装置	39	M03-101	RTA/RTP装置 (Radiance) ※注4	75,000	180,000	937,500	10,000				
	40	M04-02	ゲート酸化RTO/RTP装置 (Trias SPA300)	85,000	204,000	1,062,500	10,000				
	41	B04-01	縦型アニール装置 (VF-5700B) ※注4	20,000	160,000	250,000	10,000				
	42	M04-101	縦型酸化炉 (ALPHA-303i-K) ※注4								
洗浄装置	43	M07-15	バッチ式洗浄装置 (UW300Z) ※注4								
	44	M07-07	酸化膜ウェットエッチング装置 (VENUS) ※注4								
	45	P07-104	窒化膜ウェットエッチング装置 (SFAW-1201-008) ※注4	18,000	100,000	225,000	10,000				
	46	M07-05	バッチ式スプレー洗浄装置 (ZETA300 BE) ※注4								
	47	U07-103c	Si裏面研削研磨装置洗浄ユニット (DGP8761SC)								
	48	M07-02	枚葉式洗浄装置 (AQUASPIN MP-3000) ※注4								
	49	M07-101	枚葉式洗浄装置 (AQUASPIN SU-3000) ※注4								
	50	M07-102	枚葉式洗浄装置 (AQUASPIN SU-3000) ※注4								
	51	P07-105	枚葉式洗浄装置 (KC-A300CBT)	7,500	80,000	93,750	10,000				
	52	M07-13	枚葉式新材料洗浄装置 (SEZ323) ※注4								
	53	P07-103	小口径対応枚葉式洗浄装置 (SRWC-12801-8P-2C)								
CMP装置	54	M07-09	スクラブ洗浄装置 (AQUASPIN SS-3000) ※注4								
	55	M07-12	スクラブ洗浄装置 (AQUASPIN SS-3000) ※注4	4,800	40,000	60,000	10,000				
	56	N07-101	STI、W CMP装置 (ChaMP-332M A-FP-3000M)								
3D実装装置 (中間工程)	57	B07-101	Cu CMP装置 (ChaMP-332M A-FP-3000M)	57,000	176,000	712,500	10,000				
	58	P07-101	CMP装置 (F-REX300E)								
	59	B02-101D	Si深掘りエッチング装置 (Centura Silvia)	65,000	260,000	812,500	10,000				
	60	U03-101A	プラズマCVD装置 (PRODUCER GT InViaII)	56,000	260,000	700,000	10,000				
	61	U06-101	Cuめっき装置 (NEXX Cu ECD)	100,000	260,000	1,250,000	10,000				
	62	U07-101	Oxide CMP装置 (Reflexion LK Oxide)	114,000	260,000	1,425,000	10,000				
	63	U12-102	ウェハ接合装置 (WS3000)		260,000		10,000				
	64	U07-102	ウェハエッジトリミング装置 (DFD6860)	57,000	260,000	712,500	10,000				
	65	U07-103	Si裏面研削研磨装置 (DGP8761SC)	114,000	260,000	1,425,000	10,000				

注1～4については2ページ末尾をご参照ください。

● プロセス装置
・スーパークリーンルーム外

その他	66	AF03-16	真空蒸着装置 (VX-30-S)	35,000	112,500		10,000
	67	M04-08	評価用小片アニール装置 (VHC-P616CP-S)		74,000		10,000

● 分析装置
・スーパークリーンルーム

装置区分	No.	装置番号 ※注1	施設等名称	共用施設等使用料			技術指導費等 ※注2	
				標準レンズを使用する場合 (円/枚)	チューニングが必要な場合 (円/時間)	同一の標準レンズを使用する場合 (~25枚) (円/FOUP)		
重ね合わせ精度測定	68	M08-55	重ね合わせ精度測定装置 (Archer10-AIM)		114,000		10,000	
	69	P08-116	重ね合わせ精度測定装置 (Archer10-AIM)					
薄膜解析	70	M08-07	分光エリブノ膜厚測定装置 (ASET-F5)		28,000		10,000	
	71	M08-101	分光エリブノ膜厚測定装置 (ASET-F5X)					
	72	P08-108	分光エリブノ膜厚測定装置 (μ SE-2500-A)					
	73	I08-101	分光エリブノ膜厚測定装置 (M-2000X)					
	74	AF08-12	単色エリブノ膜厚測定装置 (MARY-102SM)					
	75	P08-104	反射分光膜厚測定装置 (F50-EXR)					
	76	M12-08	蛍光X線膜厚測定装置 (System 3272E)			40,000		10,000
	77	F08-04	X線回折装置 (TTR In-plane XRD)		56,000		10,000	
反り・応力測定	78	B12-101	反り/膜応力自動測定装置 (128LC2C)					
	79	M08-12	反り/膜応力測定装置 (128L)		24,000		10,000	
パーティクル検査	80	P08-105	パーティクル検査装置 (WM-10)					
	81	P08-106	パーティクル検査装置 (WM-10)		56,000		10,000	
金属汚染検査	82	P08-107	全反射蛍光X線分析装置 (TXRF 310Fab) ※注5					
	83	P08-109	自動濃縮装置 (Expert)		40,000		10,000	
		P08-113	ICP-MS質量分析装置 (NexION 2000) ※注3 ※注5					
抵抗測定	84	M08-10	シート抵抗測定装置 (RS-100)					
	85	M08-25	シート抵抗測定装置 (VR-120/08)		12,000		10,000	
	86	P08-102	シート抵抗測定装置 (VR300DSE)					
SEM観察	87	I08-110	測長SEM装置 (CG5000)		30,000		10,000	
	88	L08-103	測長SEM装置 (CG4000)					
	89	P08-101	測長SEM装置 (S-9380 II)					
	90	P08-103	測長SEM装置 (S-9380 II)			24,000		10,000
	91	P08-115	レビューSEM (SEMVision G6)			108,000		10,000
光学顕微鏡	92	M08-40	光学顕微鏡 (AL3110F)		4,000		10,000	
	93	M08-50	光学顕微鏡 (AL3110F)					
	94	M12-101	光学顕微鏡 (AL110)					
	95	M12-102	光学顕微鏡 (AL120)					
3D実装評価装置	96	P08-110	超音波顕微鏡 (FastLine P300) ※注5		24,000		10,000	
	97	P08-111	高精度微細形状測定機 (ET4000L) ※注5					
	98	P08-112	赤外線顕微鏡システム (DSI-300SA-IR) ※注5		10,000		10,000	
	99	P08-114	赤外線拡大鏡 (BL-3000A) ※注5		4,000		10,000	

・スーパークリーンルーム外

高分解能観察	100	J04-106	ヘリウムイオン顕微鏡 (ORION Plus)		32,000		10,000	
FIB加工/STEM	101	B08-02-01	FIB装置 (FB2100) ※注5		18,000		10,000	
	102	AF08-402	走査透過電子顕微鏡 (HD-2700) ※注5		24,000		10,000	
	103	B08-02	走査透過電子顕微鏡 (HD-2000) ※注5					
断面SEM	104	J03-117	走査電子顕微鏡 (S-4700) ※注5		10,000		10,000	
	105	M08-04	走査電子顕微鏡 (S-5000) ※注5					
	106	B08-12	走査電子顕微鏡 (S-5200) ※注5					
分析	107	AF08-14	X線光電子分光分析装置 (ESCA-1800)		40,000		10,000	
	108	B10-06	IR-OBIRCH解析装置 (μ AMOS)		40,000		10,000	
	109	J03-116	昇温脱離ガス分析装置 (WA1000S/W)		38,000		10,000	
	110	J03-114	赤外分光分析装置 (Excalibur FTS-3000)		44,000		10,000	
電気特性評価	111	J03-118	フルオートブローバ (P-12XL) テスター (4073B/N9201A)		38,000		10,000	
	112	M08-42 M10-01	フルオートブローバ (P-12XL) テスター (4073A) ※注3					
	113	M10-05	フルオートブローバ (P-12XL) テスター (4076)					
	114	F10-01	セミオートブローバ (S300-861) テスター (4156C/4284A/4294A)					
	115	M10-04 M08-47	セミオートブローバ (S300-561) テスター (4156C/4284A/4294A) ※注3			30,000		10,000
	116	B10-04 B10-05	マニュアルブローバ (Model 9920A) テスター (4156B/4284A) ※注3					
	117	J03-115	水銀ブローバ (SSM 5130)			38,000		10,000
シミュレータ	118	SIM-01	露光シミュレータ (PROLITH) ※注5		40,000		10,000	

注1 装置番号は、SCRで装置管理のために使用している番号です。

注2 技術指導費等は、装置使用方法の指導、あるいは特別な作業依頼の場合に、利用者と協議の上で適用いたします。

注3 これらの装置はセットでのご利用となります。

注4 利用促進、中小企業支援、アカデミック利用のいずれかに該当し、かつ、操作方法習得済の利用者自身による夜間流動の場合、FOUP単位料金の50%減額を行います。

注5 プロセス装置をご利用になられる方のみにご利用提供している装置です。

※この単価表に基づく料金に、運営管理費(15%)と消費税が加算されます。(共用施設等利用約款別表第2)

※来所して装置をご利用いただく場合は、利用者に係る人頭経費を徴収させていただきます。(連携研究等経費算定要領別表第3)

※消費税等により生じた小数点以下の端数については切捨てで処理いたします。